Report



金属箔材の結晶方位制御を志向した

マイクロ CCB 装置の開発

Y. Takayama

高山 善匡*

1. 緒言

近年,環境負荷低減あるいはエネルギー節減の観点から, 材料のリサイクル性を高めることが益々重要となっている. リサイクル性を高める方策として,合金組成の単純化・統合 あるいは希少資源元素・毒性元素の非添加の重要性が指摘さ れ,組成調整重視型材料開発から,プロセス制御重視型材料 開発への転換が求められている.

著者らは、新しい組織制御プロセスとして、板材表面 を超強加工,内部を低加工し得る連続繰り返し曲げ加工 (Continuous Cyclic Bending; CCB)^{1,2)}を提案し,その後の焼き なましを組み合わせることにより、Al-Mg 系合金および純ア ルミニウム板材において表面の粗粒層から内部の細粒層へ傾 斜的に組織制御できること,粗粒層が先鋭化された強い優 先方位「立方体方位」を呈することを明らかにした^{3,4)}.ま た、工業用純チタン板材に CCB と焼きなましにより表面層 に T-texture (TD//<0001>) が形成され⁵), 高純度チタン板材 では板幅方向に CCB を施すことにより圧延集合組織成分 が 発達する。ことが明らかとなっている. さらに, 最近では無 酸素銅板材に CCB を適用し、表面層の組織および集合組織 変化ならびに応力緩和特性に及ぼす CCB の影響が調べられ ている^{7,8)}. Al-Mg 系合金については CCB およびその後の焼 きなましを施した材料の引張特性¹および疲労特性⁹が調査 され、CCB/ 焼鈍材の疲労寿命は静的強度が等しい受入れ材 のそれに比べて2から4倍程度長いという興味深い結果が得 られている.

このように,連続繰り返し曲げ加工(CCB)は,板材の結 晶方位制御に有効であり,材料特性の改善に利用できる.し かしながら,電解コンデンサ箔,超伝導材料基板材料など, 電子材料を中心に,板よりも薄い箔材の結晶方位制御が望ま れている.

本研究では、厚さ100µm 程度の箔材を加工する「マイク ロ CCB 装置」を開発し、最適なプロセス条件、すなわち1 パスあたりのひずみ量、CCB 速度等を明らかにする.さらに、 CCB とその後の熱処理、(CCB/熱処理)プロセスの繰り返 しによる結晶方位分布変化を系統的に調べ、結晶方位分布制 御のための基礎的知見を得るとともに、工業的な応用の可能 性を検討する.

2. 実験方法

2.1 実験装置の概要

図1に、本研究で開発した金属箔加工用マイクロ CCB(連続繰り返し曲げ加工)装置の概観を示す.マイクロ CCB装置の主要部分(図2)は、点対称に千鳥状に配置された4つ

*宇都宮大学大学院工学研究部 教授

のロールよりなり,その間を箔材が通り貫けることにより曲 げ加工される.そのロール径は3mmである.ロール間を通 した箔材は,一端をロードセルと結合したつかみ部に固定し, 自動位置決め装置により水平方向に駆動させることにより連 続的に曲げ加工される.駆動速度は可変である.箔を一回通 り抜ける加工を1パスと呼ぶ.このパスを繰り返すことによ り,箔材表面に原理的に無限大のひずみを導入することがで きる.



図1 マイクロ CCB 装置概観



図2 マイクロ CCB ロール部

2.2 試料

供試材には、高純度アルミニウム箔材を用いる. 比較のため、厚さ 1.5mm の板材も用いた. 表1に、供試材として用いた高純度アルミニウム板材および箔材の化学組成を示す.

板材は圧延方向と平行になるように幅 20mm × 長さ 200mm × 厚さ 1.5mm のワークピースに切り出した後,最

表1 高純度アルミニウムの化学組成 (mass ppm)

| | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al(%) |
|-------|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-------|
| Sheet | 33 | 28 | 17 | 2 | Tr. | 1 | 6 | 0.5 | 99.99 |
| Foil | 8 | 8 | 50 | - | - | - | - | - | 99.99 |

大50パスのCCBを施し、熱処理を行った。箔材もまた幅 10mm×長さ50mm×厚さ0.132mmに切り出し、最大100 パスの CCB を施した. その後,小試験片に切り出しさらに この小試験片に研磨を施し,SEM/EBSP 法による結晶方位解 析を行った.

2.3 CCB条件

本研究で用いた CCB 1 パスによって与えられる板材表面 における真ひずみは 0.02761 であり、曲げ加工の真ひずみが 加算的であるとすれば、連続繰り返し曲げ加工回数 N_{CCB}=50 では1.3804となる.一方,箔材ではN_{CCB}=20では3.344とな る強加工である.

2.4 エッチング条件およびSEM観察

エッチングは試料表面の酸化皮膜除去後, 1L 当たり塩酸 1.0mol + 硫酸 3.5mol + アルミ 0.4mol を含む溶液を作成し, 70℃に加温後,直流電流 200mA/cm² で 10sec 通電すること により行った.その後にエッチピットの SEM 観察を行った. 結晶方位解析は、ワークピースを小試験片に切り出し、電解 研磨した後, SEM/EBSD(Electron Back Scatter diffraction) 法を 用いて行った.

3. 実験結果

3.1 板材のCCB / 熱処理による組織変化

立方体方位集合組織を発達させる方法として部分焼鈍 (Partially Annealing; PA) と付加圧延の工程を最終焼鈍前に行 うことが知られている.本研究でもPAの効果を確かめるた めに PA 後 CCB を行い、その後最終焼鈍 (FA) を施した. そ の結果,図3に示されるように受入材ではCube方位率が2.9% しか確認できず,解析範囲の多くがS方位粒などであった. この受入材に CCB/FA を施した場合, Cube 方位率が増加し たがそれほど高い値ではない.ところが PA+ CCB/FA 材で は著しく Cube 方位が発達し、その解析範囲に占める割合は 75.2% に達した. これは受入材の 26 倍に及ぶものであった.

3.2 箔材のCCB / 熱処理による組織変化

結晶粒内の蓄積ひずみをEBSD法で得られるKernel Average Misorientation(KAM) により評価した. KAM は, 幾 何学的必要 (GN) 転位密度に対応し、ひずみ量を評価し得る 値である. GN 転位密度を ρ , KAM を θ , 転位のバーガース ベクトルの大きさをb, EBSD 解析の解析点間距離(ステッ プサイズ)を d,転位配列の幾何学に依存する定数をαとす れば、次式で表される^{10,11)}.

$$\rho \approx \frac{\alpha \theta}{bd} \tag{2}$$

ここで, αは純粋な傾角粒界とねじり粒界に対してそれぞ れ2あるいは4である. さらに、単位体積当たりの蓄積エネ ルギーEは、次式で与えられる.

$$E = \frac{1}{2}\rho Gb^{z} \approx \frac{\alpha \theta Gb}{2d}$$
(3)

ここで, G は剛性率である. KAM 値が大きいことは加工 時に蓄積ひずみが大きいことを意味する.

Cube 方位粒の蓄積されるひずみを他方位と比較するため, PA 後 N_{CCB}=3 行った後の Orientation Map を図 4 に KAM Map を図5にそれぞれ示す. 前述の通り, KAM Map は蓄積され るひずみに対応し、色が薄いほどひずみが小さいと考えられ







図 4 Al 箔材の結晶方位マップ(注 2)

る. その結果, PA 温度 503K では Cube 方位粒は他方位に比 べ色が薄くひずみが少ないことが明瞭に判る. これは Cube 方位粒がひずみを蓄積しにくいことを表している. そのため に FA 時に Cube 方位粒は優先的に試料表面を覆うことがで



図 5 Al 箔材の KAM マップ

きると考えられる.

高純度 Al 箔材に 483K, 503K, 523K の 3 種類の温度で PA を施し, 1Pass の付加的 CCB とその後 773K-3.6ks の最終 焼鈍 (FA) をした後,結晶方位解析を行った. その結果, 上記の結果と合致し,最も低い 483K の PA 条件において FA 後の Cube 方位率 99.2%が達成された. この結果はマイクロ CCB の工業的な応用の可能性を示すものとして興味が持た れる.

3.3 マイクロCCB装置の荷重変化

図6にマイクロ CCB 加工における引張荷重と CCB パス回数の関係を示す. アルミニウム箔材は CCB により表面層が硬化し,結果としてマイクロ CCB 時の荷重も増加している. 箔材の断面は 15mm × 0.132mm であり,加わる引張応力は,約 1.3MPa から 1.9MPa 程度に増加していることになる. 図のような引張荷重の穏やかな増加は,Al 箔にマイクロ CCB が良好に施されていることを示すものと考えられる.



図6マイクロCCB加工時の引張荷重とCCB回数の関係

3.4 マイクロCCBによる硬さ変化

前節のように、本実験では連続繰り返し曲げ加工中に加わ る荷重は、CCB 回数の増加とともに増加する傾向を示した. そこで、アルミニウム箔材に CCB による加工硬化が生じて いるかどうかを確認するために、ビッカース硬さ試験を行っ た. なお、本実験では、圧痕の深さが箔厚 110µm の 1/5 以 下になるように、負荷荷重を 0.49N (50gf) に設定した.

図7に各連続繰り返し曲げ加工回数におけるビッカース 硬さを示す.図のように、CCB回数が増加するに伴い硬さ も増加していることがわかる.しかしながら、その増加は CCB加工時の引張荷重の増加に比べると小さい.4Nのアル ミニウム板材では連続繰り返し曲げ加工回数の増加に伴っ



図7 マイクロ CCB 後の Al 箔のビッカース硬さ

て硬さも増加し、ビッカース硬さが 20HV 程度まで増加する と、その後は一定値となった¹²⁾. これは高純度アルミニウ ムの結果であるが、転位密度が飽和状態に近づいたためと考 えられる. このことから本研究で用いる箔材では、板材と 比較して圧延による圧下率が非常に高く、さらにマイクロ CCB では板材での CCB よりも与えられるひずみ量が大きい ため、すでに転位密度が飽和状態になっているものと考えら れる. つまり、室温 (25℃;298K) は純アルミニウムの融点 *Tm* (660℃;933K) により表せば 0.32*Tm* と高く、室温でも 回復が起こる可能性がある. よって、飽和状態は、加工硬化 と回復が釣り合った状態と考えられる.

3.5 マイクロCCB後の試料表面状況

図8にマイクロ CCB 後のアルミニウム箔の表面状況を示 す.図のように、10パス、50パス、100パスと CCB を繰り 返すことにより、箔表面に線状の変形模様が形成され、表面 の凹凸が激しくなっている.板材の CCB でもみられるよう に、CCB 回数が少ない場合は板厚方向表面近傍にひずみが 集中するが、CCB 回数が進むとひずみが内部まで進行する ものと考えられる.このため、CCB 回数が大きい場合には 箔全体の反りを伴い、表面の凹凸が激しくなるものと考え られる.さらに、100パスの場合には、幅方向端部に1.5mm 程度の細かい線状のしわが形成されている.以上のように、 マイクロ CCB 装置により、箔材に加工を施すことが可能で あることが確かめられた.



図8 マイクロ CCB 後の Al 箔の表面状況

3.6 マイクロCCBによる試料寸法変化 図9はワークピースのマイクロ CCB による試料寸法変化



を元の長さに対する割合として表したものである. なお,長 さ変化は箔材表面に 100mm 間隔の2標点を設け,標点間距 離の変化から算出した.厚さと幅は,両標点での測定値の平 均とした.図のように,板材の長さは連続繰り返し曲げ加工 回数 N_{CCB} の増加に伴い増加し, $N_{CCB}=100$ で約7.5%になっ ている.板幅の変化は3%程度であり,相対的に小さい.一 方,板厚は比較的大きく減少し,その変化は $N_{CCB}=50$ で約9% に達している.高純度アルミニウム箔は,強度が低く,マイ クロ CCB 時の引張により幾分塑性変形するといえる.しか しながら,加工ひずみの大きさと比べると,全体的には形状 変化小さく,マイクロ CCB の特徴が現れているといえる.

3.7 CCBパス回数と蓄積ひずみの関係

CCB 加工された試料を SEM/EBSP 法により結晶方位分布 解析することにより,結晶粒内方位差を調べることができ る.この結晶粒内方位差は,加工による GN(geometrically necessary)転位の密度に対応するため,蓄積ひずみの指標と して用いることができる.ここでは,結晶粒内方位差として, KAM(Kernel Average Misorientation)を用いる.

対象視野全体の平均 KAM と CCB 回数の関係を図 10 に 示す.多少のばらつきは見られるものの, CCB 回数の増加 に伴い, KAM が増加することがわかる. CCB 回数が 50 パ スあるいは 100 パスと大きくなった場合には, 高純度 Al で は室温での回復が避けられないと考えられる.したがって,





CCB 回数が大きい試料の KAM は幾分過小評価されている 可能性がある. その点を考慮すれば, CCB 回数の増加に伴 う KAM の増加は明白であるといえる.

3.8 CCB後のエッチング特性

受入材, CCB 材に対してそれぞれエッチング処理し,表面の SEM 観察を行った.図11 に受入材,6パスおよび100パス CCB 材の SEM 写真を示す.図のように,CCB によりひずみが蓄積された試料は連結したエッチピットが広い領域で観察された.受入材と比較すると,CCB 材のエッチピットの量が多いことは明らかである.また100パス CCB では,エッチピットが密集しており,加工により蓄積された転位がエッチピットの起点になることが確かめられた.以上のように,CCB を施すことによって試料表面にひずみを与え,それがエッチング後の表面組織に強く影響を及ぼすことが示された.



図 11 エッチング後の表面 SEM 写真 (a) 受入材, (b) 6パス CCB 材, (c) 100パス CCB 材

4. 結言

本研究では、厚さ100µm 程度の箔材を加工する「マイク ロ CCB 装置」を開発し、CCB とその後の熱処理、(CCB/熱 処理)プロセスによる結晶方位分布変化を調べ、結晶方位分 布制御のための基礎的知見を得るとともに、工業的な応用の 可能性を検討した.得られた結果は以下の通りである.

- (1) アルミニウム (AI) 箔材の熱処理において, Cube 方位 粒の優先成長が確認された.また,部分焼きなまし (PA) 温度が低い場合には Cube 方位粒と他の方位粒の間にひ ずみの差が現れたのに対し,高い PA 温度では大きな差 は見られなかった.
- (2) 高純度 Al 箔材に PA 後 1Pass/773K-3.6ks の付加的 CCB を施し、その後最終焼鈍することにより、Cube 方位率 99.2%が達成された.この結果はマイクロ CCB の工業 的な応用の可能性を示すものである.
- (3) マイクロ CCB 装置により高純度 Al 箔を加工する際の 引張荷重は CCB パス回数の増加に伴って増加し,表 面状況から箔材表面にひずみが蓄えられることが分 かった.また,SEM/EBSD 解析により,結晶粒内方位 差 KAM を求めた結果,CCB パス回数の増加に伴って, GN 転位密度,すなわち蓄積ひずみが増加することが確 かめられた.
- (4) 高純度 Al 箔材の CCB 後のエッチング特性を調べた結果,受入材に比べ,CCB 材ではエッチピットの量が増加することが分かった.また,6パス CCB 材に比べて100パス CCB 材ではエッチピットが高密度に形成されることが明らかとなった.よって,CCB により導入される転位を制御することにより,Al 箔のエッチピット形成状態を制御できる可能性が示唆された.

謝辞

本研究は,財団法人天田金属加工機械技術振興財団(現公 益財団法人天田財団)の一般研究開発助成のもとに遂行され た. 同財団の助成に対し、心よりお礼申し上げる.また、試料を提供された東洋アルミニウム株式会社ならびに三菱アル ミニウム株式会社に感謝の意を表する.

参考文献

- Y. Takayama, M. Yamaguchi, T. Tozawa, H. Kato, H. Watanabe and T. Izawa, Proc. fourth Intern. Conf. Recrystallization and Related Phenomena (JIMIS10), JIM, (1999), pp.321-326.
- 2) 高山善匡: 塑性と加工, 45(2004), 507-512.
- Y. Takayama, J. A. Szpunar and H.T. Jeong, Mater. Trans. 42(2001), 2050-2058.
- Y. Takayama, Y. Uchiyama, T. Arakawa, M. Kobayashi and H. Kato, Mater. Trans., 48(2007), 1992-1997.
- 高山善匡,西郷宜恭,高橋隆一,加藤一,軽金属, 52(2002),566-571.
- Y. Takayama, T. Miura, H. Kato and H. Watanabe, Mater. Trans., 45(2004), 2826-2831.
- Sharifah Norhafizah, 高山善匡, 渡部英男, 銅および銅合 金, 51(2012), 37-41.
- Sharifah Norhafizah, 高山善匡, 渡部英男, 銅および銅合 金, 52(2013), 103-108.
- Y. Takayama, J. Sasaki, H. Kato, and H. Watanabe, Mater. Trans., 45(2004), 1833-1838.
- Q. Liu, D.J. Jensen and N. Hansen: Acta Mater., 46 (1998), 5819-5838.
- Y. Takayama and J.A. Szpunar: Mater. Trans. 45(2004), 2316-2325.
- 12) 荒川剛:宇都宮大学修士論文 (2003).
- (注1)(注2):本論文は、天田財団のホームページにカラー 版で掲載されます。